








	<h2 style="color: red;">FQD6N25TF</h2> <p>Hersteller-Teilenummer: FQD6N25TF</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 250V 4.4A DPAK</p> <p>Datenblätter: 1.FQD6N25TF.pdf 2.FQD6N25TF.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 2791 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQD6N25TF
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 250V 4.4A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	2791 pcs Stock
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 45W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	250V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	4.4A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1 Ohm @ 2.2A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	8.5nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	300pF @ 25V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

FQD6N25TF ist neu im Original. Suche FQD6N25TF Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQD6N25TF Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQD6N25TF: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQD630TF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 7A DPAK</p>	 <p>FQD6N25TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 4.4A DPAK</p>	 <p>FQD630TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 7A DPAK</p>	 <p>FQD6N25 FAIRCHI FQD6N25 FAIRCHI</p>
 <p>FQD6N40C Fairchi FQD6N40C Fairchi</p>	 <p>FQD630TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 7A DPAK</p>	 <p>FQD6N25TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 4.4A DPAK</p>	 <p>FQD6N40 FAIRCHI FQD6N40 FAIRCHI</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ FQD5N40TM	↔ FQD5N50C	⇒ FQD5N50CTF	D FQD5N50CTF	↔ FQD5N50CTM
⊣ FQD5N50CTM	⊗ FQD5N50CTM-NL	D FQD5N50TF	⇒ FQD5N50TF	↔ FQD5N60C
⊗ FQD5N60CTF	⊣ FQD5N60CTF	⊗ FQD5N60CTM	↔ FQD5N60CTM	↔ FQD5P10TF
D FQD5P10TF	⊗ FQD5P10TM	⊣ FQD5P10TM	⊗ FQD5P20TM	↔ FQD5P20TM
⇒ FQD630TF	↔ FQD630TF	⊗ FQD630TM	⊣ FQD630TM	↔ FQD6N25TF
↔ FQD6N25TM	⇒ FQD6N25TM	D FQD6N40C	⊗ FQD6N40CTM	⊣ FQD6N40CTM
⊗ FQD6N50CTF	D FQD6N50CTF	⇒ FQD6N50CTM	↔ FQD6N50CTM	↔ FQD6N60C
⊣ FQD6N60CS	⊗ FQD6N60CTF	↔ FQD6N60CTM	⇒ FQD6N60CTM	↔ FQD6P25TM
⊗ FQD6P25TM	⊣ FQD7N10L	⊗ FQD7N10LTF	D FQD7N10LTF	↔ FQD7N10LTM
↔ FQD7N10LTM	⊗ FQD7N10TF	⊣ FQD7N10TM	⊗ FQD7N10TM	↔ FQD7N20L

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited